

光刻胶EN3120A1 E3502

产品名称	光刻胶EN3120A1 E3502
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

KMP E3200系列光刻胶是专为Lift Off工艺开发的紫外负性光刻胶，相比E3100，其膜厚更厚，覆盖的范围为6.0-12.0um。其具有可调整的倒梯角度、分辨率高、工艺窗口大及易去胶等优点，广泛用于LED芯片制造过程中的Lift Off工艺，特别是LED高功率器件以及倒装工艺芯片制造过程。

EN3120A1	R:2 μ m@4 μ m,Thickness:4.5-9.5 μ m , High heat resistance	IC/LED
E3130A	Lift off negative resist,High resolution	IC/LED
E3260A2/S	R:5 μ m@8 μ m,<100mj/cm2,Thicknes s:6-12 μ m	IC/LED
E3502	R:0.6 μ m@2.4 μ m,Thickness:2-4 μ m ,Easy strip	IC/LED
E3510	R:6 μ m@14 μ m,Thickness:5-20 μ m, Easy strip	IC/LED
E3175/B	R:2.0 μ m@3.8 μ m,Small undercut, Thickness:2-4 μ m	IC/LED

KMP DK1081是低活化能体系的高分辨深紫外正性光刻胶，适用于8寸逻辑电路制程180nm节点的关键金属层，同时适用于8寸逻辑130nm及12寸64层存储的离子注入层，在光硅基底及抗反射层基底上都具有良好的工艺窗口和解析度。